

XC61Fシリ - ズ 遅延回路内蔵 電圧検出器

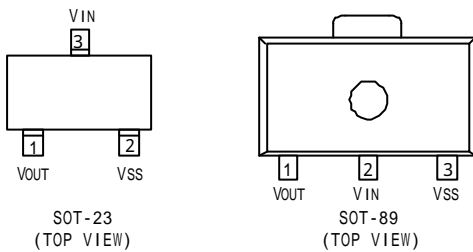
概要

XC61Fシリーズは、遅延回路を内蔵した電圧検出器です。CMOSプロセスとレーザートリミング技術を用いて、高精度、低消費電流を実現しています。検出電圧は、高精度かつ温度ドリフトが極めて小さくなっております。出力回路は、NchオープンドレインとCMOSの2種類があります。遅延回路を内蔵しているため外付け部品が不要になり、高密度実装が実現できます。

特長

- 高精度 : 設定電圧精度 $\pm 2\%$
 - 低消費電流 : TYP 1.0 μ A (VIN = 2.0V)
 - 検出電圧範囲 : 1.6V ~ 6.0Vまで0.1Vステップで設定可能
 - 動作電圧範囲 : 0.7V ~ 10.0V
 - 検出電圧温度特性 : TYP ± 100 ppm/
 - 遅延回路内蔵 : 1ms ~ 50ms, 50ms ~ 200ms, 80ms ~ 400ms
 - 出力形態 : Nchオープンドレイン、またはCMOS出力
 - 超小型パッケージ : SOT-23(150mW) ミニモールド
SOT-89(500mW) ミニパワーモールド
- (注) 本製品には設定電圧 $\pm 1\%$ 品はありません。

端子配列

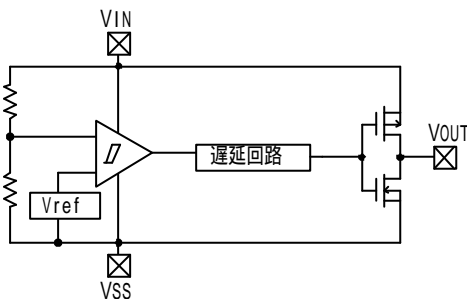


端子説明

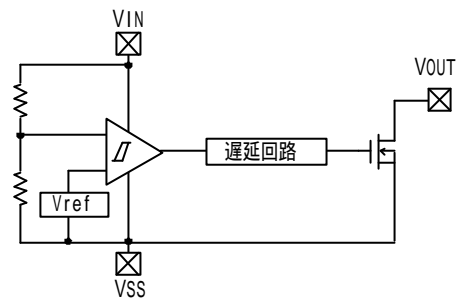
端子番号		端子名	機能
SOT-23	SOT-89		
3	2	VIN	電源入力
2	3	VSS	GND
1	1	VOUT	出力

ブロック図

(1) CMOS出力



(2) Nchオープンドレイン出力



品番ルール

XC61Fxxxxxx

a b c d e f

記号	内容	記号	内容
a	出力形態を表します。 C : CMOS出力 N : Nch出力	e	パッケージを表します。 M : SOT-23 P : SOT-89
b	検出電圧(VDF)を表します。 例) 25 : 2.5V 38 : 3.8V		
c	伝搬遅延時間を表します。 1 : 50ms ~ 200ms 4 : 80ms ~ 400ms 5 : 1ms ~ 50ms	f	収納形態を表します。 R : エンボステ - プ 標準挿入 L : エンボステ - プ 逆挿入
d	検出精度を表します。 2 : $\pm 2.0\%$ 以内		